

关键指标

频率: 6~18GHz
增益: 25dB
噪声系数: 1.5dB
1dB 压缩点输出功率: 17dBm
电压/电流: +5V/76mA
芯片尺寸: 1.7mm×0.9mm×0.1mm

产品简介

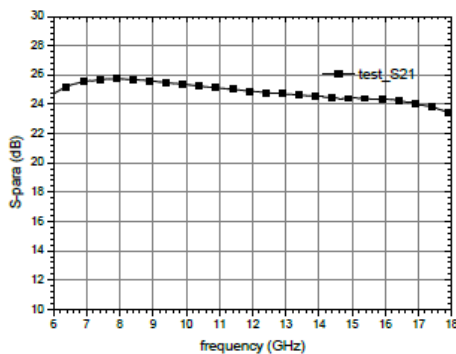
HG116F-3 是一款 6~18GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 25dB, 噪声系数为 1.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 17dBm。

电性能 (T_A=25°C, VD1=VD2= +5V)

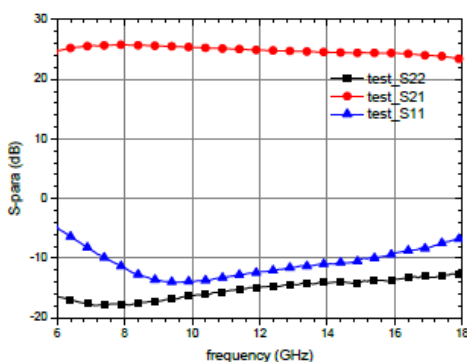
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
增益(dB)	-	25	-
增益平坦度(dB)	-	±1.25	-
噪声系数(dB)	-	1.5	-
输入回波损耗(dB)	-	-10	-
输出回波损耗(dB)	-	-15	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	17	-
输出三阶交调分量(dBm)	-	26	-
静态电流 (mA)	-	76	-

典型测试曲线

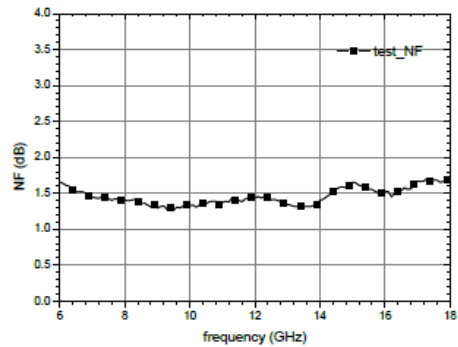
增益



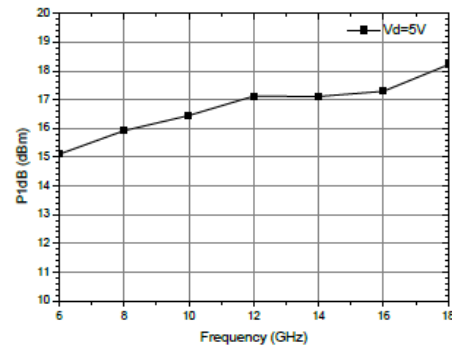
频率响应



噪声系数

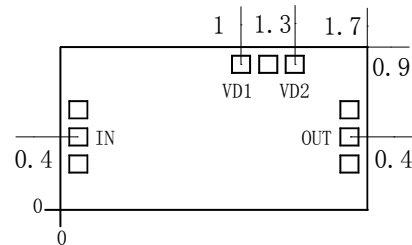


1dB 压缩点输出功率



工作电压(V)	4	5
工作电流(mA)	67	76

外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端有隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。